

一般社団法人 半導体産業人協会
理事長 内海忠
講演企画委員長 増原利明

2017年9月度 SSIS フォーラム開催案内

平素、SSIS フォーラムにご出席いただき、厚くお礼申し上げます。2017年9月度フォーラムは下記の内容で開催する予定です。奮ってご出席、ご討論にご参加いただければ幸いです。

講演タイトル

「MOS 電界効果トランジスタの揺籃期からバブルの時代までの研究
— Si/SiO₂系を中心とした研究とエピソード —」

講師

菅野 卓雄氏 東京大学 名誉教授

< 講演要旨 >

シリコン MOS 電界効果トランジスタ(MOSFET)が発明されバイポーラトランジスタ(BPT)より製造プロセスが簡易であると期待されたが、ゲートに電圧を加えると電気的特性が変化するという不安定性が顕在化し、実用化が疑問視された時期があった。シリコン酸化膜研究会は私的な会合であったがこの問題解決に向けた産官学の情報共有の場として機能した。当時の MOSFET は動作速度が BPT より遅いことが次に問題になったが、文部省科学研究費補助金(特定研究)「表面エレクトロニクス」や表面量子化を主たる課題とする日米セミナーなどを通じて MOSFET のチャネルでのキャリア輸送現象の理解が進み、この問題解決の一助となった。その間東大ではクリーンルームが建設され、また講演者は 1970 年代後半から顕在化した日米半導体摩擦に関するスタンフォード大学での研究プロジェクトの日本側代表を務め、また実現したのは東京大学停年退官後あったが大規模集積回路設計教育・研究センター設置の構想案を纏める等研究活動が拡大、加速、充実していった経緯と反省を述べる。

< 開催要領 >

1. 日時 2017年9月28日(木) 17時30分～20時
2. 場所 林野会館(文京区大塚、地下鉄茗荷谷)
3. プログラム

17:30～19:00 講演 (5F ホール)

講師 菅野 卓雄氏

「MOS 電界効果トランジスタの揺籃期からバブルの時代までの研究
— Si/SiO₂ 系を中心とした研究とエピソード —」

19:00～20:00 交流会 (6F 604 号室)

4. 参加費

SSIS 会員 3,000 円(交流会参加費含)

一般会員 4,000 円(講演のみ)

6,000 円(講演および交流会)

参加費は当日会場にて申し受けます。なお、会員でない方は当日の入会が可能です。

5. 参加申し込み

SSIS 事務局行(FAX:03-6457-3246 E-Mail :info@sis.or.jp でも承ります)

SSIS フォーラム 参加申込票

9月28日(木)のSSIS フォーラムに出席します。

お名前:

電話:

所属:

区分: SSIS 会員 []

NEDIA 会員 []

一般 [] 講演のみ参加、[] 講演および交流会参加



SSIS フォーラムの情報および協会の活動の最新情報は、ホームページでご覧いただけます。<http://www.ssis.or.jp>